

MEMS間の結合 4

チャンネルと集積化されたヘルムホルツコイル

by S.H. Lee et al.

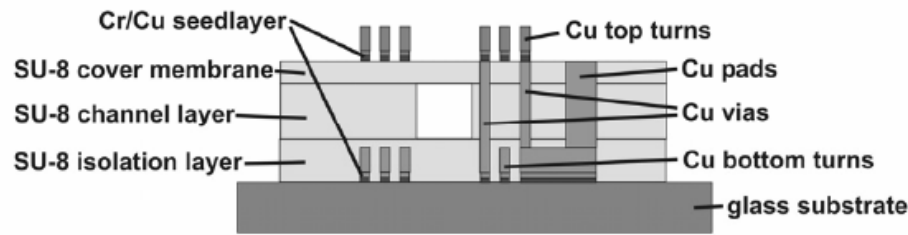


Figure 1: Schematic cross-section of a Helmholtz coil.

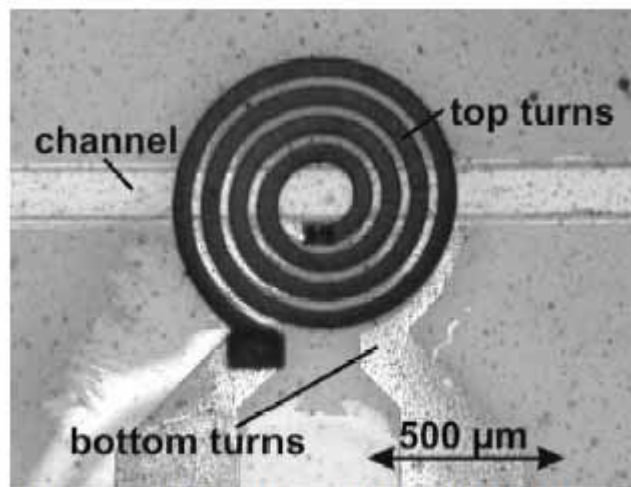


Figure 2: Helmholtz coil with 160 μm inner diameter. The distance between top and bottom turns is 85 μm. The channel has a height of 65 and a width of 120 μm.

ウェハレベル接合により形成された容量型絶対圧センサ

by K.R. Lee et al.

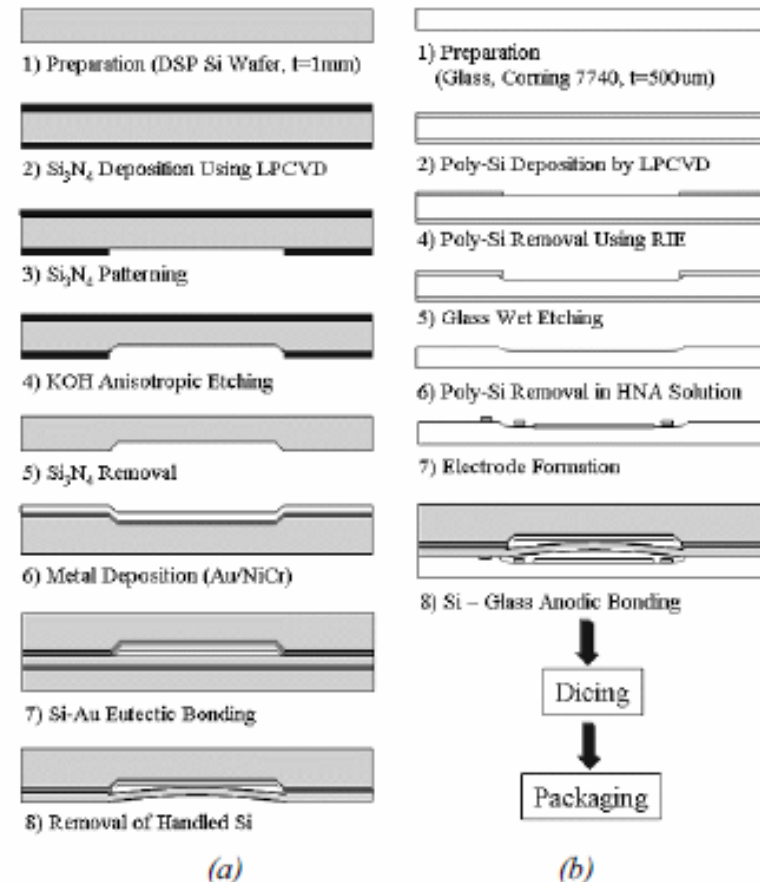


Figure 1: Experimental procedure for fabrication of capacitive absolute pressure sensors; a) fabrication process of diaphragm sealed under vacuum using SOI wafer, and b) wafer level sensors and chip.

1. SOIウェハとのウェハレベルでのSi - Au共晶点接合により、ダイヤフラムを真空封止する。
2. 電極が形成されたガラス基板との陽極接合により、ウェハレベルセンサが作製される。